

**次世代デジタル家電とコンピュータエンタテインメント・システムの核となる
65nm半導体の量産体制構築に向け、第2期投資約1200億円を実施**

ソニー株式会社（以下、ソニー）と株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（同、SCEI）は、ウエハ径300ミリメートル、65ナノメートル・プロセスに対応した半導体量産体制構築に向けて、2003年度の投資約730億円に続き、第2期として約1200億円の設備投資を行うことを決定しました。

ソニー・グループでは、半導体を商品の差異化および付加価値の源となる重要な技術として位置付けています。今回の65ナノメートル・プロセスに対応する設備投資については、既に決定済の総額約2000億円（2003年度から3年間の総額：2003年4月21日発表）の半導体設備投資の一部として実施するもので、ソニー・グループのさまざまな次世代デジタルCE（コンシューマ・エレクトロニクス）機器群や、次世代コンピュータエンタテインメント・システムを支える高性能汎用ネットワーク・プロセッサ（コードネーム：CELL）や、多彩なメディア・プロセッサ群の生産に大きく寄与するものと期待しています。

今回の第2期投資分約1200億円は、300ミリメートル・ウエハを中心とした65ナノメートル・プロセスによる半導体量産に向けた生産設備の一層の拡充を図るものです。投資の対象となる拠点は、SCEIが長崎県諫早市に保有するSCE Fab2 1階クリーンルーム、およびIBMコーポレーション（同、IBM）が保有する米国生産拠点イースト・フィッシュキル工場、株式会社東芝（同、東芝）が保有する同社大分工場新棟内の3箇所で、ソニー・グループとして投資を実行するものです。

第2期投資の内訳は、約530億円がSCE Fab2 1階に敷設した300ミリメートル・65ナノメートル・プロセス対応ラインの増強分で、SOIプロセス・テクノロジーを用いたCELLを始めとする超高速プロセッサの生産に充てられます。同時に、約360億円をIBMイースト・フィッシュキル工場に投じ、同じくSOIプロセス・テクノロジーを用いたCELLを始めとする65ナノメートル・プロセス世代の超高速プロセッサ群の製造を計画しています。また、東芝への設備投資については、本年度分からの投資とあわせて約420億円（第2期分約310億円）の設備投資を行い、DRAM混載CMOSテクノロジーを活用した65ナノメートル・プロセス世代の半導体生産拠点を立ち上げます。なお、同新棟への設備投資では、東芝からも同額の設備投資を予定しています。

各設備の試験稼働開始は、2005年前半を目標とし、3拠点あわせて約15000枚/月の生産能力を予定しています。

現在、ソニー・グループでは、IBM、東芝とともに、ブロードバンドネットワーク時代の基幹となる高性能次世代汎用プロセッサ群の開発設計や、最先端の半導体プロセス技術開発を進めています。今回の設備投資により、最先端半導体プロセス技術開発の成果を量産と同等の環境下で検証することが可能となり、次世代半導体の開発設計完了に向けた量産体制の構築やスムーズな量産立ち上げを目指します。

ソニー・グループは、今後も最先端の半導体プロセス・テクノロジーをベースに、最先端プロセッサ群の開発を積極的に推し進め、CCDなどのイメージングデバイスの強化と共に、市場が急進しているデジタルCE市場およびコンピュータエンタテインメント市場に向け、高性能で使いやすい製品開発を進めます。